

Technical-News

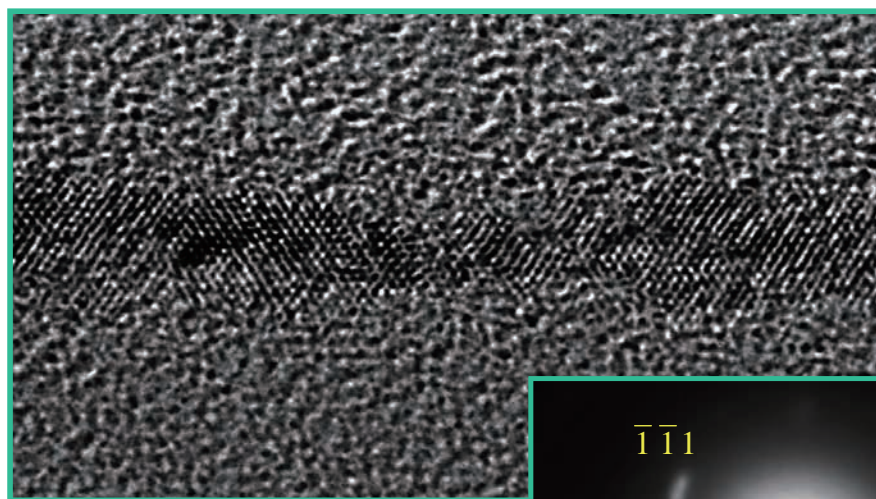
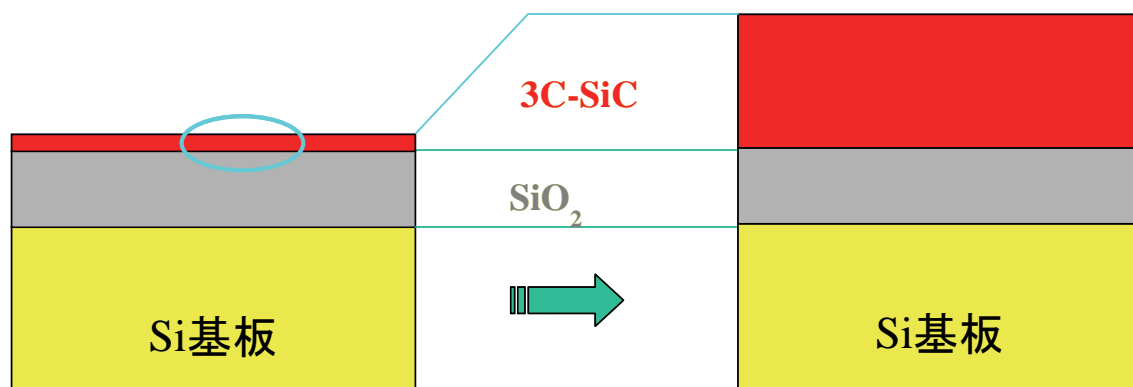
HR-TEMによるSiC-3Cの観察

TEM-10

株式会社イオンテクノセンター

材料の形態評価にはナノスケールのレベルで構造を観察できる HR-TEM（高分解能透過型電子顕微鏡）が不可欠です。

ここでは下記の図のように SOI 基板に SiC を成長させたサンプルを HR-TEM（日本電子：JEM-4000EX）により観察した例を紹介します。大面積の Si 基板に格子定数の異なる SiC を成長させる方法として注目されています。TEM 像の下側が酸化膜で格子像が SiC-3C に相当します。



お問合せ窓口

イオンテクノセンター技術営業部
E-mail: info@iontc.co.jp

TEL:072-859-6601 / FAX:072-859-5770
URL: <http://www.iontc.co.jp>